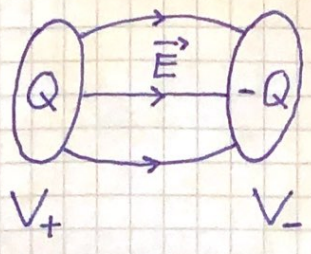


Kondensator. Kapasitans [052 8 ; YF 24 ; LHL 20]

To adskilte ledere = en kondensator (capacitor)

Ladning $\pm Q$ på lederne \Rightarrow felt \vec{E}



Coulombs lov $\Rightarrow E$ prop. med Q

\Rightarrow potensialforskjellen (spenningen)

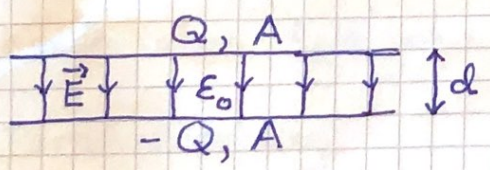
$V = V_+ - V_-$ prop. med Q

Kondensatorens kapasitans (capacitance):

$C = Q/V$; $[C] = \frac{C}{V} = F$ (farad)

Kretssymbol :

Eks: Platekondensator



$E = \sigma/\epsilon_0 = Q/A\epsilon_0$
 $V = E \cdot d = Qd/A\epsilon_0$
 $\Rightarrow C = \epsilon_0 A/d$

Med $d = 10^{-3} m$, $A = \pi \cdot (0.10m)^2$: $C = 0.28 nF$

Dielektrikum mellom platene øker kapasitansen :

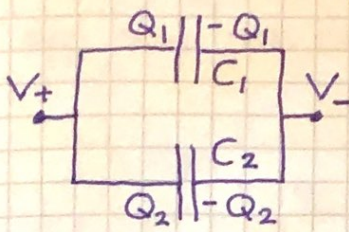
$\epsilon_0 \rightarrow \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \Rightarrow E = \sigma/\epsilon = Q/A\epsilon_r\epsilon_0 = V/d$
 $\Rightarrow C = \epsilon_r \epsilon_0 A/d$, økt med en faktor ϵ_r

Enhet for permittivitet :

$[\epsilon] = [C \cdot d/A] = F/m$

Kobling av kapasitanser [OS2 8.2; YF 24.2; LHL 20.2] (63)

Parallellkobling: Lik spenning $V = V_+ - V_- = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}$



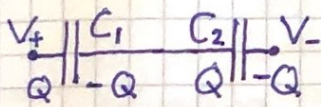
over C_1 og C_2 , som lagrer total

ladning $Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V$,

slik at total kapasitans blir

$$C = Q/V = C_1 + C_2$$

Seriekobling:



Lik ladning $Q = C_1 V_1 = C_2 V_2$ på C_1 og C_2 , og total spenning $V = V_1 + V_2$ betyr

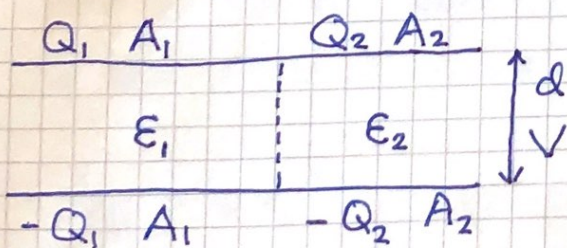
at total kapasitans C er gitt ved

$$V = V_+ - V_- \quad \frac{1}{C} = \frac{V}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

N kapasitanser i parallell: $C = \sum_{j=1}^N C_j$; i serie: $\frac{1}{C} = \sum_{j=1}^N \frac{1}{C_j}$

Kondensator fylt med ulike dielektrika:

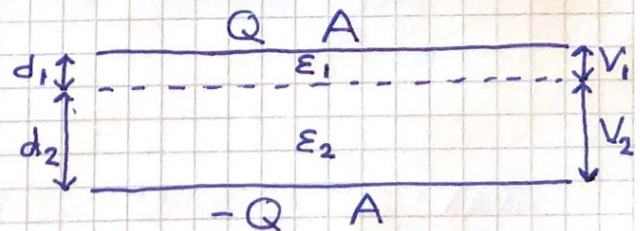
Parallellkobling



$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_1 A_1}{d} + \frac{\epsilon_2 A_2}{d}$$

Seriekobling



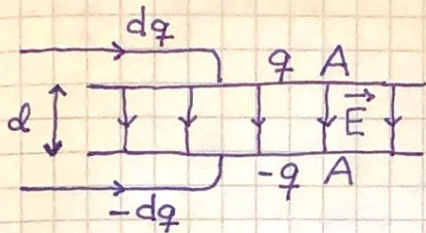
$$V = V_1 + V_2$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d_1}{\epsilon_1 A} + \frac{d_2}{\epsilon_2 A}$$

Energi i \vec{E} -felt [OS2 8.3; YF 24.3; LHL 20.4]

64

Opplading av en kondensator krever et arbeid, som ender opp som pot. energi lagret i \vec{E} -feltet mellom platene.



$v(q) = q/C =$ pot. forskjell mellom platene med ladning $\pm q$;
økning til ladning $\pm (q+dq)$ øker den potensielle energien med
 $dU = v(q) dq = q dq / C$

\Rightarrow Opplading fra $q=0$ til $q=Q$ gir total pot. energi :

$$U = \int dU = \int_0^Q q dq / C = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2$$

Bruker $C = \epsilon_0 A / d$ og $V = E \cdot d$ og får

$$U = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} (E \cdot d)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \cdot (A \cdot d)$$

Her er $A \cdot d$ volumet mellom platene, der vi har $E \neq 0$. Dermed :

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \text{energi pr volumenhet i } \vec{E}\text{-feltet}$$

som gjelder generelt.

Eks: Beregn energitettheten i feltet mellom platene når $d = 1.0 \text{ mm}$ og $V = 1.0 \text{ kV}$.

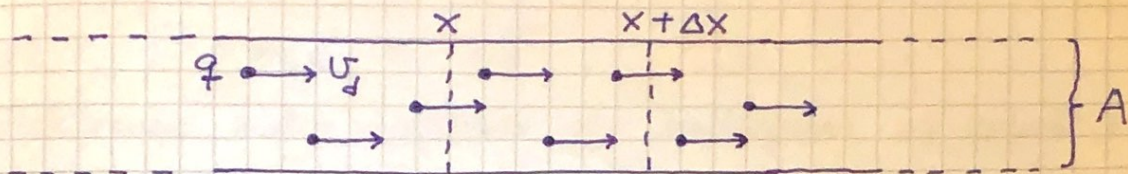
$$\text{Løsn: } u_E = 0.5 \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \cdot (1000/0.001)^2 \text{ J/m}^3 = \underline{4.4 \text{ J/m}^3}$$

Elektrisk strøm [052 9,10; YF 25,26; LHL 21,22]

(65)

Strøm og strømtetthet [052 9.1,9.2; YF 25.1; LHL 21.1]

Ser på leder med tverrsnitt A , med n frie ladninger q pr volumenheter som har midlere driftshastighet v_d langs lederen:



strøm $\stackrel{\text{def}}{=} \text{mengden ladning som passerer et tverrsnitt av lederen pr tidsenhet}$

$$I = \Delta Q / \Delta t \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} dQ/dt ; [I] = \frac{C}{s} = A \text{ (ampere)}$$

I løpet av tiden $\Delta t = \Delta x / v_d$ passerer alle frie ladninger, dvs ladningsmengden $q n A \Delta x$ i volumet $A \Delta x$, tverrsnittet ved $x + \Delta x$

$$\Rightarrow I = q n A \Delta x / (\Delta x / v_d) = n q v_d A$$

strømtetthet $\stackrel{\text{def}}{=} \text{strøm pr flateenhet}$

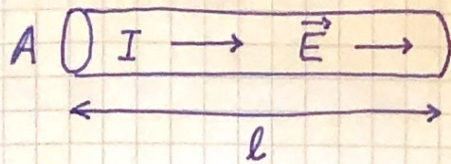
$$j = I/A = n q v_d \Rightarrow \vec{j} = n q \vec{v}_d ; [j] = A/m^2$$

I metall er de frie ladningene elektroner med $q = -e$, slik at $\vec{j} = -n e \vec{v}_d$

—————
—————> elektrisk strøm
—————<— elektronstrøm
—————

Ohms lov [OS2 9.2-9.4; YF 25.2, 25.6; LHL 21.2, 21.4] (66)

Anta spenning V over leder med lengde l og tverrsnitt A (og som er del av en lukket krets):



$$V = E \cdot l ; j = I/A$$

$$N2 : \vec{F} = m_e \vec{a} = -e\vec{E}$$

Elektronene møter motstand pga kollisjoner og oppnår en midlere driftshastighet $\vec{v}_d = \vec{a} \cdot \tau$, der τ er midlere tid mellom kollisjoner. Dermed:

$$\vec{j} = -ne\vec{v}_d = -ne \cdot (-e\vec{E}/m_e) \cdot \tau = \sigma \cdot \vec{E}$$

med $\sigma = ne^2\tau/m_e =$ materialets elektriske ledningsevne (= konduktivitet). Dette er P. Drudes modell (ca 1900) for Ohms lov, på mikroskopisk form. Med $j = I/A$ og $E = V/l$ får vi Ohms lov på makroskopisk form:

$$V = R \cdot I ; R = l/\sigma A = \text{lederens motstand (resistans)}$$

Lederens konduktans: $G = R^{-1} \Rightarrow I = G \cdot V ; G = \sigma A/l$

Materialets resistivitet: $\rho = \sigma^{-1} \Rightarrow \vec{j} = \vec{E}/\rho$

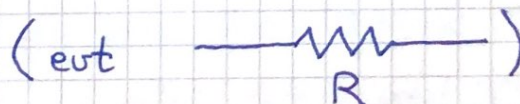
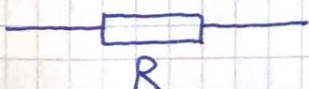
Enheter: $[R] = V/A = \Omega$ (ohm)

$[G] = \Omega^{-1} = S$ (siemens)

$[\rho] = \Omega \cdot m$

$[\sigma] = \Omega^{-1} m^{-1} = S/m$

Kretssymbol:



Eks: Anslå ledningsevnen til kobber.

(67)

Løsn: Siden $\sigma = ne^2\tau/m_e$, trenger vi estimater for n og τ . Kobber har molar masse 63 g/mol og massetetthet ca 9 g/cm³, og vi antar 1 fritt elektron pr atom

$$\Rightarrow n \approx \frac{9 \cdot 10^6 \text{ g/m}^3}{63 \text{ g/mol}} \cdot 6 \cdot 10^{23} \text{ elektroner/mol} \approx 10^{29} \frac{\text{elektroner}}{\text{m}^3}$$

Midlere tid mellom kollisjoner: $\tau = d/v_T$

Midlere lengde mellom kollisjoner: $d \approx 1 \text{ nm}$

Midlere elektronfart: Kinetisk energi pr partikkel i elektrongassen er prop. med absolutt temperatur T ,

$$\frac{1}{2} m_e v_T^2 = \frac{3}{2} k_B T; \quad k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} = \text{Boltzmanns konstant}$$

$$\Rightarrow v_T = \sqrt{3k_B T/m_e} \approx 10^5 \text{ m/s ved romtemp. (ca 300K)}$$

Dermed: $\tau \approx 10^{-9} \text{ m} / 10^5 \text{ m/s} = 10^{-14} \text{ s}$

slik at $n \cdot \tau \approx 10^{15} \text{ s/m}^3$.

Videre er $e^2/m_e = 2.8 \cdot 10^{-8} \text{ C}^2/\text{kg}$ slik at ledningsevnen til kobber er ca $\sigma \approx 3 \cdot 10^7 \text{ S/m}$.

Ekspenimentelt er $\sigma \approx 6 \cdot 10^7 \text{ S/m}$.

Hvis $A = 2.5 \text{ mm}^2$ og $I = 1.0 \text{ A}$ blir driftshastigheten

$$v_d = j/ne = I/neA \approx 2.5 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}$$

$g(T)$ [OS 29.3; YF 25.2; LHL 21.2, 21.5]

Metall: Økt $T \Rightarrow$ kortere tid τ mellom kollisjoner $\Rightarrow g$ øker

Exp: $g(T) = g_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$; $\alpha \approx 0.004 \text{ K}^{-1}$

$g_0 = g(T_0)$ ved referansetemp. f.eks 293 K (20°C)

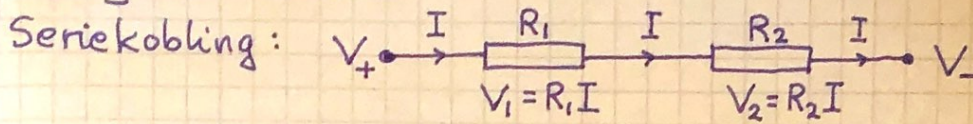
Halvleder (Si, Ge, GaAs, ...): Isolator, $n \approx 0$ ved $T = 0 \text{ K}$.

Økt $T \Rightarrow n$ øker $\Rightarrow g$ øker

Anvendelser: Diode, transistor, solcelle osv

Kobling av motstander [OS2 10.2; YF 26.1; LHL 21.3]

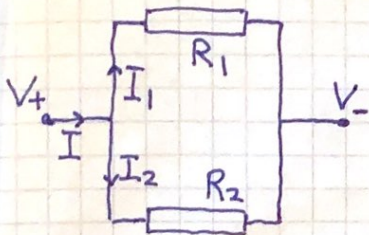
(68)



Lik strøm I gjennom motstander i serie

$$\text{Total spenning: } V = V_+ - V_- = V_1 + V_2 = (R_1 + R_2)I$$
$$\Rightarrow R = V/I = R_1 + R_2$$

Parallellkobling:



Lik spenning over R_1 og R_2 :

$$V = R_1 I_1 = R_2 I_2$$

$$\text{Total strøm: } I = I_1 + I_2 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = \frac{V}{R}$$

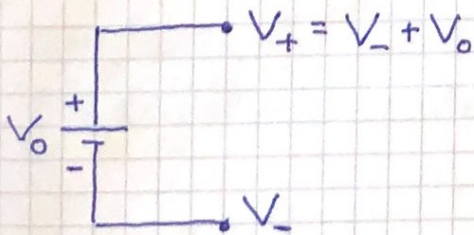
$$\Rightarrow R^{-1} = R_1^{-1} + R_2^{-1}$$

$$\text{Med } N \text{ i serie: } R = \sum_{j=1}^N R_j ; \quad \text{i parallell: } R^{-1} = \sum_{j=1}^N R_j^{-1}$$

DC-kretser [OS2 10 (9); YF 26 (25); LHL 22]

DC = direct current = likestrøm

Likespenningskilde:



Sørger for konstant spenning $V_+ - V_- = V_0$ mellom polene.

Eks: Kjemisk batteri. Solcelle.
Mobillader.

Kirchhoffs regler [OS2 10.3; YF 26.2; LHL 22.3]

(69)

- K1: Pga ladningsbevarelse er netto strøm inn mot og ut av et knutepunkt like store, $\sum_j I_j = 0$.
Fortegn: $I_j > 0$ inn, $I_j < 0$ ut (eller omvendt)
- K2: Pga energibevarelse er summen av potensialendringer rundt en lukket sløyfe null, $\sum_j V_j = 0$.
Fortegn: $V_j > 0$ for potensialøkning (eller omvendt)

Elektrisk effekt [OS2 9.5; YF 25.5; LHL 22.2]



$$\text{Effekt inn: } P_{\text{inn}} = dU_{\text{inn}}/dt = V_+ dQ/dt = V_+ I$$

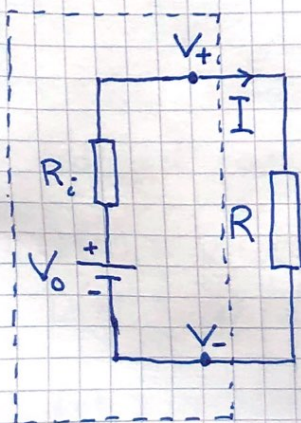
$$\text{--- ut: } P_{\text{ut}} = dU_{\text{ut}}/dt = V_- dQ/dt = V_- I$$

$$\text{Effekttap i lederbiten: } P = P_{\text{inn}} - P_{\text{ut}} = (V_+ - V_-) \cdot I = V \cdot I$$

$$\text{Hvis ohmsk motstand: } V = RI \Rightarrow P = VI = RI^2 = V^2/R$$

Eksempler:

Eks 1: Reell vs ideell spenningskilde



$$K2: V_0 - R_i I - RI = 0$$

$$\Rightarrow I = \frac{V_0}{R_i + R}$$

R_i = indre motstand i reell spenningskilde

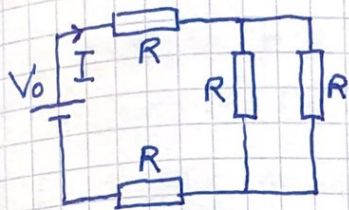
$R_i = 0$ i ideell spenningskilde

Pdspanning:

$$V_+ - V_- = V_0 - R_i I < 0 \text{ n\u00e5r } R_i \gg 0 \text{ (og } I > 0)$$

Eks 2: Hva er total motstand?

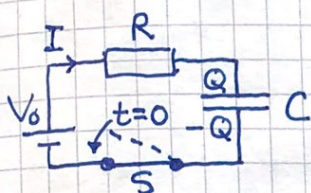
(70)



$$R_{\text{tot}} = R + (R^{-1} + R^{-1})^{-1} + R = \underline{\underline{5R/2}}$$

$$(\Rightarrow I = 2V_0/5R)$$

Eks 3: RC-krets [OS2 10.5; YF 26.4; LHL 22.4]



Bestem $Q(t)$ og $I(t)$ når bryteren S lukkes ved $t=0$ og $Q(t=0) = 0$, for

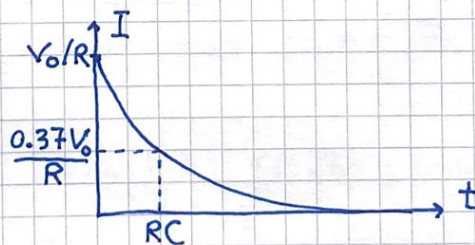
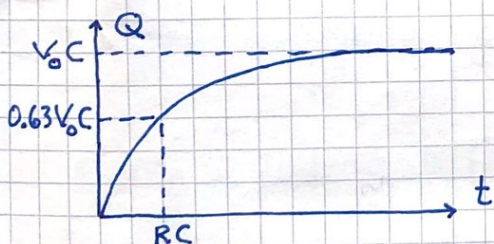
(a) $R = 100 \Omega$, $C = 100 \text{ nF}$; (b) $R = 1 \text{ M}\Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$

$$K2 \Rightarrow V_0 - RI - Q/C = 0 ; I = dQ/dt$$

$$\Rightarrow RC dQ/dt = V_0 C - Q \Rightarrow \int_0^Q \frac{dQ}{Q - V_0 C} = - \int_0^t \frac{dt}{RC}$$

$$\Rightarrow \ln \left\{ \frac{Q - V_0 C}{-V_0 C} \right\} = -t/RC$$

$$\Rightarrow Q(t) = V_0 C \{ 1 - e^{-t/RC} \} ; I(t) = \frac{dQ}{dt} = \frac{V_0}{R} e^{-t/RC}$$



$\tau = RC$ = kretsens tidskonstant = et mål for hvor lang tid det tar å lade opp kondensatoren

$$Q(\tau) = V_0 C (1 - e^{-1}) \approx 0.63 V_0 C ; Q(3\tau) \approx 0.95 V_0 C$$

$$I(\tau) = \frac{V_0}{R} \cdot e^{-1} \approx 0.37 V_0 / R ; I(3\tau) \approx 0.05 V_0 / R$$

$$(a) \tau = 100 \Omega \cdot 10^{-7} \text{ F} = 10^{-5} \text{ s}$$

$$(b) \tau = 10^6 \Omega \cdot 10^{-6} \text{ F} = 1 \text{ s}$$